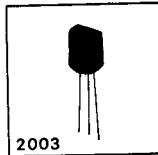


2SA1017

2SC2363

低周波電力増幅
40 - 50W出力
フリドライバ用



PNP / NPN Epitaxial Planar Type Silicon Transistor

For Predriver of 40 to 50 W AF Amplifier

- ★A complementary pair.
- ★() shows 2SA1017 only.
- ★For the details, see 2SC2363 section.

⊖ C511B

()内は 2SA1017の場合を示しす。

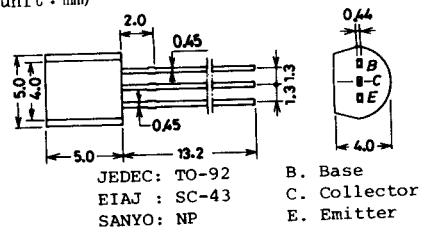
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ\text{C}$		unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	(-) 120 V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	(-) 100 V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	(-) 5 V
コレクタ電流	I_C	(-) 50 mA
ピークコレクタ電流	i_{cp}	(-) 100 mA
コレクタ損失	P_C	500 mW
接合部温度	T_j	125 $^\circ\text{C}$
保存周囲温度	T_{stg}	-55 ~ +125 $^\circ\text{C}$

電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ\text{C}$		min	typ	max	unit
コレクタシャ断電流	I_{CB0} $V_{CB} = (-) 80V, I_E = 0$		(-) 1.0		μA
エミッタシャ断電流	I_{EB0} $V_{EB} = (-) 4V, I_C = 0$		(-) 1.0		μA
直流電流増幅率	β_{FE}^* $V_{CE} = (-) 6V, I_C = (-) 1\text{mA}$	100*		560*	
利得帯域幅積	f_T $V_{CE} = (-) 6V, I_C = (-) 1\text{mA}$		(110) 130		MHz
出力容量	C_{ob} $V_{CB} = (-) 10V, f = 1\text{MHz}$	(1.0) 1.0	(2.2) 1.8	(3.0) 2.5	pF
C-E 飽和電圧	$V_{CE(sat)}$ $I_C = (-) 10\text{mA}, I_E = (-) 1\text{mA}$			(-) 0.5	V
C-B 降伏電圧	$V_{(BR)CBO}$ $I_C = (-) 10\mu\text{A}, I_E = 0$	(-) 120			V
C-E 降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$ $I_C = (-) 1\text{mA}, R_{BE} = \infty$	(-) 100			V
E-B 降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$ $I_E = (-) 10\mu\text{A}, I_C = 0$	(-) 5			V

※ 2SA1017, 2SC2363は 1mA β_{FE} によりつぎのように分類している。

100	E	200	160	F	320	280	G	560
-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

外形図 2003
(unit: mm)



◆詳しくは2SC2363のページをご覧ください。